Magnetic Bead Signal Detection by Self-Field of PHR Sensor

Seok Soo Yoon and Dong Young Kim*

Department of Physics, Andong National University, Andong 36729, Korea

Jae-Hoon Lee, Sung-Joon Kim, and Cheol-Gi Kim

Department of Emerging Materials Science, DGIST, Deagu 42988, Korea

(Received 25 September 2019, Received in final form 5 October 2019, Accepted 7 October 2019)

We analyzed the magnetic field dependence of V_{SF} signal, which second harmonic signal was generated by self-field of planner Hall resistance (PHR) sensor. The V_{SF} signal was proportional to the product of sensitivity of PHR sensor and self-field. The magnetic field dependence of bead signal detected by V_{SF} signal showed maximum value at H=0. The bead signal detected by using the Self-field sensor operated at H=0 showed linear behavior up to 1/100 bead concentration. Thus, the Self-field sensor can be applied to the external field free biosensor.

Keywords : planner Hall resistance, self-field, bead concentration, biosensor

PHR 센서의 자체 자기장을 이용한 자성 비드 신호 탐지

윤석수 · 김동영*

안동대학교 물리학과, 경북 안동시 경동로 1375, 36729

이재훈 · 김성준 · 김철기

DGIST 신물질과학전공, 대구시 달성군 현풍면 테크노중앙대로 333, 42988

(2019년 9월 25일 받음, 2019년 10월 5일 최종수정본 받음, 2019년 10월 7일 게재확정)

본 연구에서는 PHR(Planar Hall Resistance) 센서의 자체 자기장에 의해 생성된 2차 고조파 신호인 V_{SF} 신호의 자기장 의존성 을 분석하였다. V_{SF} 신호는 PHR 센서의 민감도와 자체 자기장의 곱에 비례하였으며, V_{SF} 신호로 측정한 자기장에 따른 비드 신 호는 민감도가 최대인 H=0에서 가장 크고 안정된 신호 특성을 보였다. H=0에서 자체 자기장 센서를 사용하여 탐지한 자성 비 드 신호는 농도에 따라 선형적으로 비례하는 특성을 보였으며, 1/100까지 낮은 농도의 비드 신호 측정이 기능함을 보였다. 따라 서 자체 자기장 센서는 무자장 바이오센서에 응용될 수 있다.

주제어 : 평면홀 저항, 자체 자기장, 비드 농도, 바이오센서

I.서 론

최근에 다양한 종류의 바이오 분자를 감지할 수 있는 바이 오센서 개발을 위한 연구가 활발히 진행되고 있다. 자기저항 (Magnetoresistance) 센서는 표적 바이오 분자가 흡착된 자성 비드 하나를 측정할 수 있을 정도로 민감도가 매우 우수하므 로 고분해능 바이오센서로 응용이 가능하다[1]. 거대 자기저항(Giant Magnetoresistance, GMR) 센서를 이 용하여 센서 표면에 놓인 자성 나노 입자의 위치에 따른 비 드 탐지 성능을 분석하여 최적의 바이오센서에 응용하고자 하 는 연구가 최근 Wang Group에 의하여 수행되었다[2]. 외부 자기장에 의하여 자화된 자성 나노 입자는 자기 쌍극자를 형 성하며, 쌍극자에 의한 자기장이 나노 입자의 위치에 따라 센 서에 미치는 영향을 분석하였다. 센서의 중앙에 위치한 나노 입자는 센서 표면에 아주 미미하게 작용하며 측정이 불가능 한 반면, 센서의 가장자리에 위치한 나노 입자는 센서에 사 용된 강자성체의 자화에 의해 유도된 자기장의 영향으로 측

[©] The Korean Magnetics Society. All rights reserved. *Corresponding author: Tel: +82-54-820-5445, Fax: +82-54-823-1628, e-mail: dykim@andong.ac.kr

정 가능한 신호를 발생시키는 것으로 결론지었다. 따라서 자 화량이 큰 CoFe 재료를 자유층으로 사용한 GMR 센서를 제 작하여 표적 바이오 분자가 흡착된 나노 입자를 탐지하는 질 병 진단용 키트 개발에 적용하고 있다[3-5]. 한편 평면홀 효 과(planer Hall effect)를 이용한 자기 저항 센서(PHR 센서) 가 자성 비드 측정용 바이오센서에 응용되고 있다[6-8]. PHR 센서는 강자성 박막에 흐르는 전류와 수직인 방향에서 측정 된 전기적인 신호를 이용하므로 센서의 자체 저항에 의한 오 프셋 신호는 사라지고 자기저항에 의한 신호만 측정하는 장 점이 있다.

그러나 외부 자기장에 의해 자화된 자성 비드를 탐지하는 자기저항 센서는 자기장에 의한 신호와 자성 비드에 의한 미 악한 신호가 혼합되어 측정된다. 따라서 미약한 자성비드 신 호를 추출하기 위하여 자기장에 의한 신호를 제거하는 방법 을 강구하거나, 자기장이 필요 없는 바이오센서의 개발이 필 요하다. Wang Group은 다중 라인 구조를 갖는 GMR 센서 의 라인들 사이에 나노 입자를 위치 시켜, 센서에 사용된 강 자성체의 자화에 의한 나노 입자 자화 방법을 사용하여 외부 자기장이 필요 없는 자성 비드 탐지용 바이오센서(external field free biosensor)를 제안하였다[9]. 자기장에 의한 센서 신호를 배제하고 자성 비드를 탐지하기 위하여 PHR 센서에 흐는 전류가 만드는 자체 자기장(Self-field)을 이용하는 방법 이 연구되고 있다[10-11].

본 연구에서는 전류의 방향과 자화 용이축이 평형한 PHR 센서를 제작하였다. 센서에 흐르는 전류가 만드는 자체 자기 장에 의한 2차 고조파 신호인 V_{SF}를 이용하여 자기장이 필요 없는 자성 비드 탐지용 자체 자기장 센서의 출력 신호 특성 을 검증하였으며, 검증된 자체 자기장 센서를 활용하여 농도 에 따른 자성 비드 신호를 측정하였다.

II. 실험 방법

PHR 센서에 사용한 Ta(5)/NiFe(20)/Cu(0.5)/IrMn(10)/Ta(5) (단위: nm)구조의 자성 박막은 DC 마그네트론 스터퍼링 방 법으로 증착하였다. 박막 증착 시 초기 진공은 10⁻⁸ Torr 이 하였으며, Ar 공정 압력은 3 mTorr로 하였다. 150 Oe의 자기 장을 인가하여 반강자성체인 IrMn과 강자성체인 NiFe 계면 효과로 나타나는 교환 결합력의 방향을 센서의 길이 방향과 평행하게 형성시켰다. 한편, 센서의 민감도를 향상시키기 위 하여 0.5 nm 두께의 Cu를 IrMn과 NiFe 사이에 증착하여 교 환 결합력의 세기를 감소시켰다. PHR 센서는 광식각 및 건 식 에칭 공정을 통하여 100 × 200 μm² 크기로 제작하였으며, 제작한 센서의 구조는 Fig. 1에 삽입한 사진에서 보인 것과 같다.



Fig. 1. (Color online) Magnetic field dependence of V_{PHR} signal. The insert figure shows the photography of PHR sensor.

PHR 센서의 평면홀 효과 특성을 분석하기 위하여 자기장 에 따른 출력 신호 V_{PHR}을 Lock-in amplifier(SR830)을 이 용하여 전류의 수직 방향에서 측정하였다. 측정에 사용한 전 류는 400 Hz의 주파수(f)를 갖는 교류 전류를 사용하였으며, 전류의 세기 I = 55 mA이었다. V_{PHR}은 인가한 교류 전류의 주파수와 동일한 400 Hz의 신호를 -65 Oe~65 Oe의 자기장 범위를 왕복하며 측정하였다. PHR 센서의 자체 자기장에 의 한 V_{SF} 신호는 센서에 흐르는 전류의 주파수 f와 자체 자기 장의 주파수 f의 믹서(mixer) 특성에 기인한 2f의 주파수 특 성을 갖는다. 따라서 V_{SF}는 2f 주파수인 800 Hz의 신호를 Lock-in amplifier을 사용하여 -65 Oe~65 Oe의 자기장 범위 를 왕복하며 측정하였다.

측정에 사용한 자성 비드는 산화철 나노입자로 구성된 지 름이 2.8 µm인 dynabeads[™]280 Streptavidin 원액을 사용하 였다. 자성 비드 원액을 PBS(Phosphate Buffered Saline) 용 액과 희석하여 1/100까지 자성 비드의 농도를 조절한 희석 용액을 실리콘 웨이퍼에 떨어뜨려 말린 시료를 제작하였다. 이들 시료의 유무에 따른 V_{SF} 신호의 차이로 농도에 따른 비 드 신호를 측정하였다.

III. 실험 결과 및 고찰

강자성 재료의 평면홀 효과(planar Hall effect)를 이용한 PHR 센서는 반도체 소자에 수직한 자기장을 측정하는 홀 센 서와 측정 방법은 동일하지만, 홀 센서와 달리 소자에 평행 한 자기장을 측정한다. 홀 센서는 소자에 흐르는 전류가 전 류에 수직인 자기장에 의한 자기력을 이용하지만, PHR 센서 는 궤도 전자의 스핀 산란에(s-d 산란)에 의한 자기저항 변화 를 이용한다. 이러한 평면홀 효과는 강자성 재료에 흐르는 전 류 밀도(J)와 자화 벡터(m)의 스칼라 곱에 따라 비저항이 변화되는 현상으로 나타나며, 전류와 수직인 방향으로 유도되 는 수직 전기장(E)은 다음과 같이 표현된다[12].

$$E_{\perp} = (\rho_{\parallel} - \rho_{\perp})m_{\perp}(\vec{J} \cdot \vec{m}) \tag{1}$$

여기서 ρ₁ 및 ρ₁은 자구와 전류의 방향이 서로 수직 및 수 평인 경우 각각에 대한 비저항이며, $\vec{m} = \vec{M}/M_s$ 은 자구의 단 위 벡터이며, m₁는 자구 단위 벡터의 수직 성분이다. 식(1)로 부터 PHR 센서의 출력 전압 V_{PHR}은 다음과 같이 표현된다.

$$V_{PHR} = I \frac{\Delta \rho}{t} \sin \theta \cos \theta \tag{2}$$

여기서 6는 전류와 자구 방향 사이의 각이다. V_{PHR}은 교류 전 류의 진동수 f와 동일한 진동수를 갖는 신호로 전류의 세기에 비례한다. 또한 외부 자기장에 의한 자화 방향의 변화는 sin & cos 6에 의존하는 출력 전압 특성을 갖는다. 따라서 미약한 자기장에 의하여 6가 아주 작은 경우, sin $\theta \approx \theta \approx \frac{d(sin \theta)}{dH} H$ 이 므로 식(2)는 다음과 같이 표현된다.

$$V_{H \to 0} = \frac{dV_{PHR}}{dH} H = SH$$
(3)

여기서 *S는 V_{PHR}* 신호의 기울기를 나타내는 민감도이다. *V_{PHR}* 은 미약한 자기장 영역에서 선형적으로 자기장에 비례하는 특 성이 있다. 이러한 PHR 센서는 미약한 자기장을 측정하는 자 기장 센서로 사용될 수 있다. 또한 자기장에 따른 *V_{PHR}* 신호 는 강자성 재료의 자기저항 특성 분석에 이용되고 있다.

본 연구에서 사용한 PHR 센서는 Fig. 1에 삽입된 사진에 서 보인 것과 같이 직사각형 모양으로 제작하였다. 전류 I는 센서의 길이 방향으로 인가하였으며, 출력 전압 V_{PHR}는 전류 와 수직인 방향에서 측정하였다. 전류의 방향은 자성 박막의 자화 용이축으로 작용하는 교환 결합력(*H_{ex}*)의 방향과 동일하였다. 외부 자기장 *H*는 전류와 수직인 방향으로 인가하였으며, *I*=55 mA의 전류 조건에서 측정한 자기장에 따른 V_{PHR} 은 Fig. 1에 보인 것과 같다.

식(2)에서 PHR 센서의 출력 전압은 전류와 자구 방향의 사이의 각 θ =45°인 경우 최대가 된다. 자화 용이축과 자기 장의 방향은 서로 수직이므로 전류와 자구 방향의 사이의 각 은 자기장과 유효 이방성 자기장 H_{eff} 이 같을 때 θ =45°가 된다. Fig. 1에서 보인 것과 같이 PHR 센서의 출력 전압은 식(2)에 따라 $H < H_{eff}$ ($\theta < 45°$ 인 영역)에서는 자기장에 따라 서 증가하는 특성을 보이고 있으며, $H > H_{eff}$ ($\theta > 45°$ 인 영역) 에서는 자기장에 따라서 감소하는 특성을 보인다. Fig. 1에서 V_{PHR} 이 최대가 되는 자기장으로 부터 측정한 NiFe/Cu/MnIr 다층 박막의 유효 이방성 자기장 *H_{eff}* = 11.5 Oe이었으며, *H* = 0 근처에서 PHR 센서의 최대 민감도 *S* = 0.24 mV/Oe이었다. 외부 자기장 *H*에 비례하는 비드의 자화량 *M_{bead}* ≈ 4πχ_{bead}*H*

로 표현된다. 본 연구에서 사용한 지름이 2.8 µm 자성 비드 의 자화율 Xbead ≈ 0.13 이므로 H=1 Oe 자기장에 의한 비드 자화량은 약 1.6 G가 된다. 따라서 0.24 mV/Oe의 민감도를 갖는 PHR 센서는 자기장에 의하여 자화된 비드 신호의 측정 이 가능하여야 한다. 그러나 자성 비드의 유무에 따른 PHR 센서의 출력 전압의 차이는 센서의 노이즈 수준으로 매우 작 게 측정되었다. 이는 자성 비드가 만드는 자기장이 PHR 센 서에 매우 미약하게 작용하고 있음을 의미한다. 따라서 본 연 구에서는 자체 자기장에 의한 자성 비드의 자화가 센서와 상 호작용하여 나타나는 신호 특성을 분석하였다.

PHR 센서에 흐르는 교류 전류에 의한 자체 자기장 H_{SF} 는 주파수가 f인 교류 자기장이므로 H_{SF} 에 의한 자화 벡터를 $\overrightarrow{m}_{SF}(f)$ 로 표현하면, 식(1)의 평면홀 효과에 의하여 2차 고조 파 신호 특성을 갖는 수직 전기장 $E_{\perp SF}(2f)$ 는 다음과 같이 표현된다.

$$E_{\perp SF}(2f) = (\rho_{\parallel} - \rho_{\perp})m_{\perp}(\vec{J}(f) \cdot \vec{m}_{SF}(f))$$
(4)

H_{SF}는 유효 자기장 H_{eff}에 비하여 매우 작은 크기이므로, H_{eff} ≫ H_{SF} 조건에서 미소 교류 자기장인 H_{SF}에 의한 2차 고조파의 출력 전압 V_{SF}는 삼각 함수의 곱의 항등식에 따라 다음과 같이 표현된다.

$$V_{SF} = \frac{1}{2} \frac{dV_{PHR}}{dH} H_{SF} = \frac{1}{2} S H_{SF}$$
(5)

H_{SF}는 일정한 크기이므로 식(5)에 보인 것과 같이 V_{SF}는 PHR 센서의 민감도 S에 의존하게 된다.



Fig. 2. (Color online) Magnetic field dependence of V_{SF} signal. The red line is calculated by SH_{SF} at $H_{SF} = 0.15$ Oe.

Fig. 2에서 보인 검정색 원형 표식은 자기장에 따른 *V_{SF}*를 측정한 결과이다. *V_{SF}*는 이력 특성이 거의 없는 매우 안정적인 신호 특성을 보였다. 붉은색 실선은 Fig. 1에서 측정한 *V_{PHR}* 신호의 민감도 *S*와 *H_{SF}* = 0.15 Oe를 곱한 결과이며, *V_{SF}*는 식(5)에 의하여 표현됨을 알 수 있었다. *V_{SF}*는 *H*=0 근처에 서 식(5)와 일치하는 경향을 보였으나, *H*>*H_{eff}*에서는 식(5)에 의한 결과와 약간의 차이가 생기고 있음을 보였다. 본 연구



Fig. 3. (Color online) Magnetic field dependence of V_{SF} signal with (red line) and without (black line) 1x bead sample as shown in Fig.4.



Fig. 4. (Color online) Photography of magnetic bead samples with different bead concentration. 1x, 5x, 10x, 20x, 50x and 100x correspond to the bead concentration of 1, 1/5, 1/10, 1/20, 1/50, 1/100 compared with dynabeadsTM280 Streptavidin solution, respectively.

에서는 자성 비드 탐지 성능을 분석하기 위하여 자성 비드 원액을 실리콘 웨이퍼에 떨어뜨려 말린 시료의 자기장에 따 른 *V_{sF}* 신호를 측정하였다.

Fig. 3은 자성 비드의 유무에 대하여 자기장에 따라 측정한 V_{SF} 신호의 절댓값 특성을 보인 것이다. 검정색 원형 표식은 자성비드가 없는 경우에 측정한 결과이며, 붉은색 사각형 표 식은 Fig. 4에서 보인 1x 자성 비드 시료가 있는 경우에 대 하여 측정한 V_{SF} 신호 특성을 나타낸 것이다. 비드의 유무에 따른 V_{SF}의 신호 차이는 비드 신호를 의미하며, 비드 신호는 PHR 센서의 민감도가 가장 큰 H=0에서 가장 크게 나타났 다. 따라서 H=0에서 H_{SF}를 이용하여 비드를 탐지하는 자체 자기장 센서가 가능함을 알 수 있었으며. 외부 자기장을 사 용하지 않는 자체 자기장 센서를 사용하여 농도에 따른 비드 신호를 측정하였다.

농도에 따른 비드 신호를 측정하기 위하여 제작한 시료의 자성 비드 분포는 Fig. 4에서 보인 현미경 사진과 같다. Fig. 4에서 시료의 농도 표시 1x는 자성 비드 원액을 실리콘 웨이 퍼에 떨어뜨려 말린 시료이며, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x 각 각은 자성 비드 원액을 PBS 용액에 1/5, 1/10, 1/20, 1/50, 1/100의 농도로 희석한 용액을 실리콘 웨이퍼에 떨어뜨려 말 린 시료이다.

Fig. 5에 삽입한 그림은 1x 시료를 PHR 센서 위에 올리 고 제거하는 반복 과정 동안 시간에 따라 자체 자기장 센서 로 측정한 *V_{sr}*의 변화 특성을 보여준다. 비드의 유무에 따른 신호 차이를 평균하여 비드 신호를 추출하였다. 이러한 방법 으로 농도가 다른 시편 각각에 대하여 측정한 비드 신호는 Fig. 5에 보인 것과 같다. 비드 신호는 농도 증가에 따라서 선형적으로 증가하였으며, 1/100의 농도로 희석된 시편의 신 호 측정이 가능하였다. 따라서 *H*=0에서 작동하는 자체 자



Fig. 5. (Color online) Bead concentration dependence of bead signal. The insert figure shows the time dependent V_{SF} signal for with and without 1x bead sample.

기장 센서는 바이오 마커를 부착한 자성 비드를 탐지하는 조 기 진단용 무자장 바이오센서(external field free biosensor) 개발에 응용될 수 있다.

IV. 결 론

본 연구에서는 NiFe/Cu/MnIr 자성 박막 재료를 사용하여 100 × 200 µm² 크기의 PHR 센서를 제작하였다. 자화 용이축 과 평형한 방향으로 흐르는 전류가 만드는 자체 자기장 H_{SF} 에 의한 2차 고조파 신호인 V_{SF}의 자기장 의존성을 분석하였 다. 자기장에 따른 V_{SF} 신호는 PHR 센서의 민감도와 H_{SF}의 곱에 비례하였으며, V_{SF}로 측정한 자기장에 따른 비드 신호는 민감도가 최대인 H=0에서 가장 크고 안정된 신호 특성을 보였다. 이들 결과로부터 자화 용이축과 평형한 방향으로 전 류가 흐르도록 만든 자체 자기장 센서는 H=0에서 비드 신 호 특성이 가장 우수함을 입증하였다.

측정에 사용한 자성 비드는 산화철 나노입자로 구성된 지 름이 2.8 µm인 dynabeads[™]280 Streptavidin 원액을 사용하 였으며, 자성 비드 원액의 농도를 1/100까지 조절한 용액을 실리콘 웨이퍼에 떨어뜨려 말린 시료를 제작하였다. 자체 자 기장 센서를 사용하여 H=0에서 자성 비드 시료의 유무에 따른 신호 차이로 비드 신호를 측정하였다. 자체 자기장 센 서를 사용하여 탐지한 자성 비드 신호는 농도 증가에 따라서 선형적으로 증가하였으며, 1/100의 농도로 희석된 시편의 신 호 측정이 가능함을 보였다. 따라서 H=0에서 작동하는 자 체 자기장 센서는 바이오 마커를 부착한 자성 비드를 탐지하 는 조기 진단용 무자장 바이오센서에 응용될 수 있을 것으로 기대된다.

감사의 글

이 논문은 안동대학교 기본연구지원사업에 의하여 연구되 었음.

References

- D. R. Baselt, G. U. Lee, M. Mohan, S. W. Metzger, P. E. Sheehan, and R. J. Colton, Biosens. Bioelectron 13, 731 (1998).
- [2] J. Lee, N. Sato, D. J. B. Bechstein, S. J. Osterfeld, J. Wang, A. W. Gani, D. A. Hall, and S. X. Wang, Sci. Rep. 6, 18692 (2016).
- [3] D. J. B. Bechstein, J. Lee, C. C. Ooi, A. W. Gani, K. Kim, R. J. Wilson, and S. X. Wang, Sci. Rep. 5, 11693 (2015).
- [4] T. Klein, Y. Wang, L. Tu, L. Yu, Y. Feng, W. Wang, and J. P. Wang, Sens. Actuators, A: Phys. 216, 349 (2014).
- [5] K. Wu, T. Klein, V. D. Krishna, D. Su, A. M. Perez, and J. P. Wang, ACS Sensors 11, 1594 (2017).
- [6] D. Y. Kim, B. S. Park, and C. G Kim, J. Appl. Phys. 88, 3490 (2000).
- [7] N. T. Thanh, M. G. Chun, N. D. Ha, K. Y. Kim, C. O. Kim, and C. G. Kim, J. Magn. Magn. Mater. 305, 432 (2006).
- [8] N. T. Thanh, L. T. Tu, N. D. Ha, C. O. Kim, C. G. Kim, K. H. Shin, and P. Rao, J. Appl. Phys. **101**, 053702 (2007).
- [9] P. Li, Y. Wang, T. Klein, and J. P. Wang, Appl. Phys. Lett. 104, 122401 (2014).
- [10] S. J. Han, L. Xu, R. J. Wilson, and S. X. Wang, IEEE Trans. Magn. 42, 3560 (2006).
- [11] L. Ejsing, M. F. Hansen, A. K. Menon, H. A. Ferreira, D. L. Graham, and P. P. Freitas, J. Magn. Magn. Mater. 293, 667 (2005).
- [12] T. McGuire and R. Potter, IEEE Trans. Magn. 11, 1018 (1975).